

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関
国際事務局



(43)国際公開日

2004年10月28日 (28.10.2004)

PCT

(10)国際公開番号
WO 2004/092238 A1

(51)国際特許分類⁷:

C08G 8/04, G03F 7/11

(81)指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(21)国際出願番号:

PCT/JP2004/005330

(22)国際出願日:

2004年4月14日 (14.04.2004)

(25)国際出願の言語:

日本語

(26)国際公開の言語:

日本語

(30)優先権データ:

特願2003-114044 2003年4月18日 (18.04.2003) JP

(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): 東京応化工業株式会社 (TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.) [JP/JP]; 〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 Kanagawa (JP).

(72)発明者; および

(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 中村 剛 (NAKAMURA,Tsuyoshi) [JP/JP]; 〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP).

(74)代理人: 棚井 澄雄, 外(TANAI,Sumio et al.); 〒104-8453 東京都中央区八重洲2丁目3番1号 Tokyo (JP).

(84)指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドノート」を参照。

A1 (54) Title: RESIN FOR UNDER-LAYER MATERIAL, UNDER-LAYER MATERIAL, LAMINATE AND METHOD FOR FORMING RESIST PATTERN

WO 2004/092238 A1 (54)発明の名称: 下地材用樹脂、下地材、積層体、及び多層レジストパターン形成方法

(57) Abstract: A resin for an under-layer material for use in forming an under-layer film between a substrate and a photoresist layer, which is a novolak resin containing an oligomer having a mass average molecular weight of 500 or less in an amount of 1 mass % or less as measured by the gel-permeation chromatographic method; a under-layer material comprising the resin; a laminate comprising the under-layer material; and a method for forming a resist pattern using the under-layer material.

(57)要約: 基板とホトレジスト層との間に下層膜を形成するための下地材用樹脂であって、質量平均分子量500以下の低核体の含有量がゲルペーミエーションクロマトグラフィー法において1質量%以下であるノボラック樹脂である下地材用樹脂、前記樹脂を含む下地材、前記下地材を含む積層体、及び前記下地材を用いたレジストパターン形成方法。